



圖 3-9 理想 n-MOS（為 p 型矽基底）於不同 C-V 量測條件下之電荷改變情形：(a) 電洞累積 (b) 電洞空乏 (c) 反轉時低頻量測 (d) 反轉時高頻量測。

3.3 實際的 MOS（金氧半）元件

3.3.1 實際狀況的 MOS 元件

前面所探討的 MOS 元件是假設在理想的條件下，且其於熱平衡時的能帶